

Dr. Révész Ákos

*1927-ben Balassagyarmaton született.
Vegyészmérnöki oklevelét 1950-ben szerezte, száma: 600.*

1950-ben a Vas és Fémipari Kutató Intézetben, majd az Egyesült Izzónál (Tungstam RT) dolgozott, ahol a félvezető fejlesztési osztály vezetőjének nevezték ki. Később megszervezte a Híradástechnikai Egyesület Félvezető csoportját, és az MTA Műszertechnikai Intézetének külső munkatársa lett. 1956-ban kivándorolt Hollandiába, és 1958-tól a Philips cégnél egy szilárd ion-vezetésű elektronikus kondenzátor fejlesztésén dolgozott. 1959-ben az Egyesült Államok Tudományos Akadémiája által szervezett ösztöndíj keretében Amerikába került és az RCA Vállalat központi kutató intézetében dolgozott. Főleg a Si/SiO₂ határfelület fizikai kémiája terén végzett úttörő munkát, ennek fontos szerepe volt a tér-vezérelésű tranzisztor és erre alapozott integrált áramkörök technológiájának kialakulásában. 1969-ben a COMSAT cég kutató laboratóriumában, mint kutató tevékenykedett. Megoldotta a germánium-alagút dióda meghibásodásának az okát, új eljárást dolgozott ki a szilícium napelemek fényvisszaverődésének kiküszöbölésére, aminek döntő szerepe volt a napelemek hatásfokának 50%-os növelésében. Alaputatást folytatott a nem-kristályos anyagok, főleg SiO₂ és hidrogén tartalmú amorf szilícium szerkezetek terén. 1984-től a mai napig önálló tanácsadóként dolgozik. Számos nemzetközi konferencia szervezésében vett részt. Sok neves egyetemen tartott előadásokat, mint vendég professzor. Több mint 130 közleménye jelent meg.

Az Egyetem Tanácsa **arany diploma** adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.